

EL23G

EL23G は、縦型透明でモールドされた高出力GaAs赤外発光ダイオードです。薄型・小型で実装が容易です。

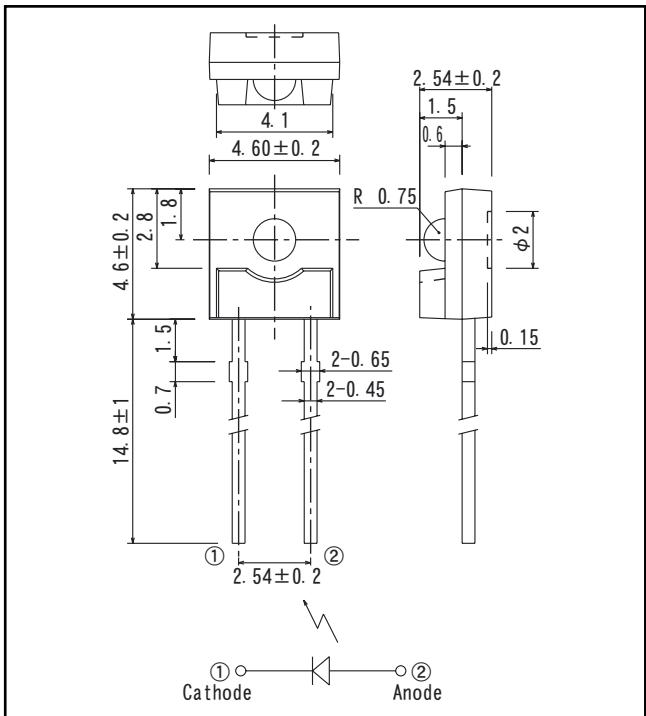
The EL23G is a high-power GaAs IRED mounted in a clear low profile side-viewing package. This IRED is both compact and easy to mount.

■特長 FEATURES

- 樹脂モールドタイプ
- 高出力
- 汎用タイプ
- Plastic mold package
- High output power
- General-use type

■用途 APPLICATIONS

- 光電スイッチ
- フォトインタラプタ
- Optical switches
- Photointerrupters

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)**■最大定格 MAXIMUM RATINGS**

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V _R	5	V
順電流 Forward current	I _F	60	mA
許容損失 Power dissipation	P _D	100	mW
パルス順電流 Pulse forward current ^{*1}	I _{FP}	1	A
動作温度 Operating temp.	T _{opr.}	-20~+100	°C
保存温度 Storage temp.	T _{stg.}	-30~+100	°C
半田付温度 Soldering temp. ^{*2}	T _{sol.}	240	°C

*1. パルス幅 : t_w=100 μs 周期 : T=10ms
pulse width : t_w≤100 μs period : T=10ms

*2. リード根元より2mm離れた所で、t=5s
For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

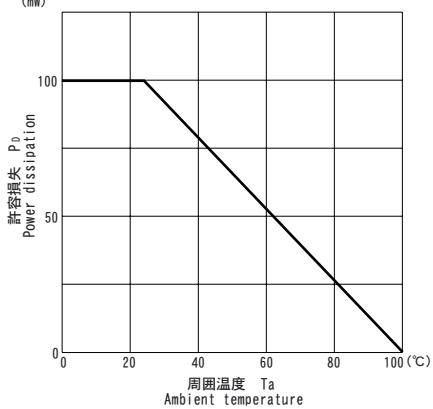
(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
順電圧 Forward voltage	V _F	I _F =60mA		1.3	1.6	V
逆電流 Reverse current	I _R	V _R =5V			10	μA
ピーク発光波長 Peak emission wavelength	λ _p	I _F =60mA		940		nm
スペクトル半値幅 Spectral bandwidth	Δλ	I _F =60mA		50		nm
発光出力 Radiant intensity	P ₀	I _F =60mA		2.0		mW/sr
半值角 Half angle	Δθ			±30		°

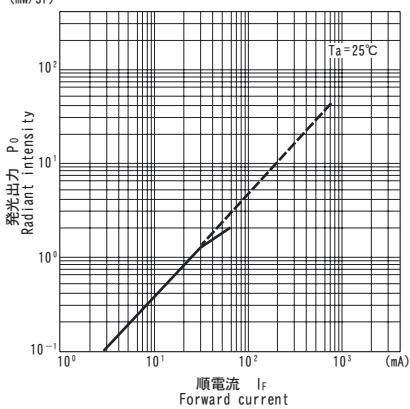
赤外発光ダイオード (GaAs) INFRARED EMITTING DIODES (GaAs)

EL23G

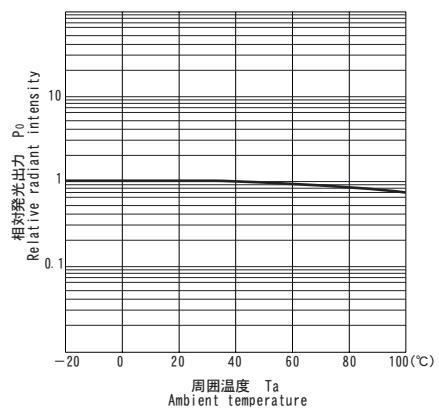
■許容損失／周囲温度 P_D/T_a



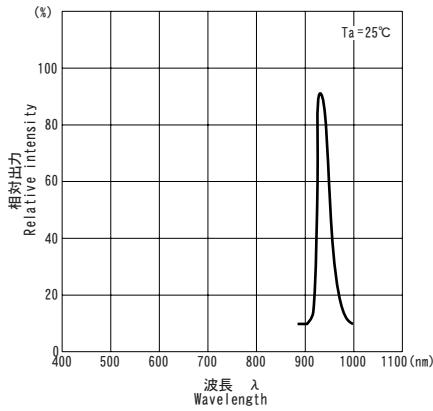
■発光出力／順電流特性 P_0/I_F



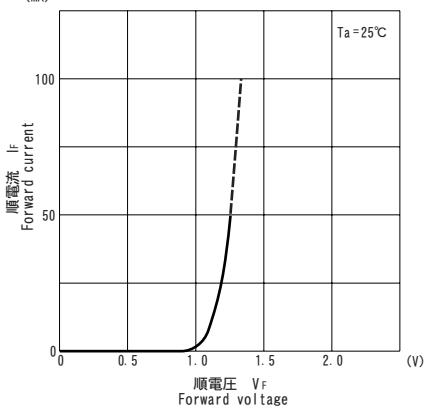
■相対発光出力／周囲温度特性 P_0/T_a



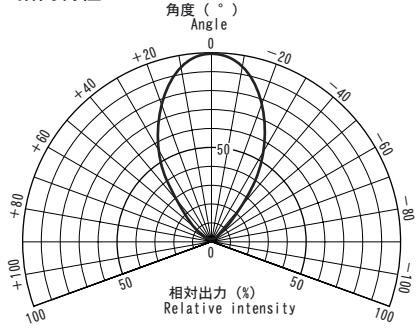
■発光スペクトル



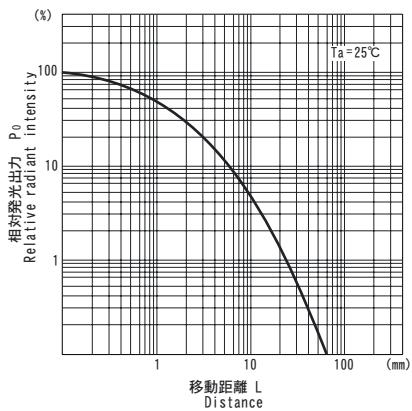
■順電流／順電圧特性 I_F/V_F



■指向特性



■相対発光出力／距離特性 P_0/L ※1



※1 相対発光出力／移動距離特性
測定方法

